



中国科学院科学出版基金资助出版

半 导 体 学 报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 19 卷 第 3 期 1998 年 3 月

目 次

硅中层错带中空位的电子态	王永良 S. Marklund (161)
S 钝化 GaAs(100)衬底上分子束外延 ZnSe 薄膜的喇曼光谱研究	史向华 靳彩霞 凌 震 俞根才 王 杰 侯晓远 (166)
硅基 $\text{SiN}_x\text{O}_y : \text{C}^+$ 薄膜的光致发光	廖良生 刘小兵 熊祖洪 何 钧 侯晓远 (172)
几种掺杂浓度的 GaAs 表面 Si- δ 掺杂结构研究	刘兴权 陆 卫 陈效双 乔怡敏 史国良 沈学础 (177)
CdSe 纳米团簇的透射电镜研究	许 燕 林兆军 陈 伟 白元强 方克明 (181)
用正电子湮没方法鉴别 InP 半导体中的缺陷	陈志权 胡新文 王少阶 (185)
AlGaAs/GaAs HEMT 中界面态对沟道层电场特性影响的二维数值研究	张兴宏 杨玉芬 王占国 (191)
GaN/6H-SiC 紫外探测器的光电流性质研究	臧 岚
杨 凯 张 荣 沈 波 陈志忠 陈 鹏 周玉刚 郑有焘 黄振春 (197)	
表面杂质浓度分布对晶体管负阻特性的影响	裴素华 薛成山 赵善麒 (202)
薄层 SOI/MOSFET's 热载流子电流的数值模拟	曹建民 吴传良 张文俊 范 辉 沈文正 黄 敞 (206)
TiN 覆盖层和 Co/Ti/Si 三元固相反应改善超薄 CoSi_2 高温稳定性	刘 京 茹国平 顾志光 屈新萍 李炳宗 朱剑豪 (214)

研究快报

低阈值 $1.3\mu\text{m}$ InGaAsP/InP 应变补偿多量子阱 DFB 激光器 LP-MOCVD 生长	陈 博 王 圩
汪孝杰 张静媛 朱洪亮 周 帆 王玉田 马朝华 张子莹 刘国利 (218)	
CoSi_2 超薄外延膜的生长研究	姚振钰 张国炳 秦复光 刘志凯 张建辉 林兰英 (221)
用 GaAs 张应变层控制 InP 衬底上 InAs 三维岛的有序排列	王本忠 赵方海 彭宇恒 刘式墉 (226)
$3\sim 5.3\mu\text{m}$ $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{Al}_y\text{Ga}_{1-y}\text{As}/\text{Al}_z\text{Ga}_{1-z}\text{As}$ 非对称台阶量子阱红外探测器 ...	吴文刚 常 凯 江德生 李月霞 郑厚植 H. C. Liu (229)
An Improved Analytical Model for Minority Carrier Transport in Quasi - Neutral Semiconductor Regions	Ma Pingxi(马平西), Zhang Lichun(张利春), Zhao Baoying(赵宝瑛) and Wang Yangyuan(王阳元) (235)